

УДК 530.145

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В РАЗОГРЕТОЙ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОЙ ПЛАЗМЕ

З. И. Васюнык, В. В. Гафийчук, Б. С. Кернер, В. В. Осипов

Предложен механизм возникновения турбулентности в разогретой высокочастотным или постоянным электрическим полем квазинейтральной электронно-дырочной плазмы (ЭДП). Численно прослежены сценарии образования и характер спонтанно возникающих в однородной ЭДП хаотических по пространству и времени неоднородных колебаний.

Предложен механизм возникновения турбулентности в разогретой высокочастотным или постоянным электрическим полем квазинейтральной электронно-дырочной плазме (ЭДП). Численно прослежены сценарии образования и характер спонтанно возникающих в однородной ЭДП хаотических по пространству и времени неоднородных колебаний.

Турбулентность наблюдается в системах при наличии в них конвективных потоков [1]. Турбулентность может спонтанно возникать и в отсутствие конвективных потоков при расслоении однородного состояния системы в результате рассмотренного в [2] механизма неустойчивости всех неоднородных стационарных состояний. В данной работе рассмотрен новый механизм неустойчивости спонтанно образующихся в электронно-дырочной плазме (ЭДП) неоднородных состояний (страт), приводящий к возникновению хаотических по пространству и времени колебаний.

Рассмотрим невырожденную ЭДП такой плотности ($n=p$), что выполнены условия ее квазигидродинамического описания. Когда эффективные массы электронов и дырок различаются не очень сильно (или в полупроводниках с вырожденной валентной зоной) вследствие эффективного обмена энергией между электронами и дырками носители в электрическом поле разогреваются как единая система до некоторой эффективной температуры T . Распределение температуры и концентрации электронов в квазинейтральной ЭДП описываются уравнениями

$$\partial n / \partial t = -\operatorname{div} j_e + G_0 + n v_i(T) - n / \tau_r, \quad (1)$$

$$3\partial(nT)/\partial t = -\operatorname{div} j_e + jE - 2n(T - T_l)\tau_e^{-1}, \quad (2)$$

где плотности потоков электронов j_e и энергии носителей j_e равны

$$j_e = -(\sigma_e/e\sigma) j - \nabla(nD), \quad (3)$$

$$j_e = -(5/2 + \alpha)[nD_e(1 + b^{-1})\nabla T - T(j/e + 2j_e)]. \quad (4)$$

Здесь G_0 — скорость тепловой и фотогенерации носителей; τ_r — время их жизни; v_i — скорость межзонной ударной ионизации; τ_e — характеристическое время релаксации энергии носителей; D_e, D — коэффициенты диффузии электронов и биполярной диффузии; $b = \mu_e/\mu_h$; $\sigma = \sigma_e + \sigma_h$; μ_e, μ_h и σ_e, σ_h — подвижности и проводимости электронов и дырок; j — плотность полного тока; T_l — температура решетки; $1 + \alpha = \partial \ln D / \partial \ln T$.

При выполнении условий

$$L \gg l, \alpha + s > -1 \quad (5)$$

однородное состояние ЭДП становится неустойчивым, когда ее температура $T > T_0 = (2 + \alpha + s)(1 + \alpha + s)^{-1}T_l$, и в плазме скачкообразно образуются страты в виде слоев высокой температуры и низкой концентрации носителей (рис. 1), перпендикулярных линиям тока [3]. В (5) $s = -\partial \ln \tau_e / \partial \ln T$; $L = (D^0 \tau_r)^{1/2}$ — длина биполярной диффузии; $l = [5/2 + \alpha] \tau_e D_e^0 (1 + b^{-1})/2]^{1/2}$ — длина остывания электронов; $D^0 = D(T_l)$; $D_e^0 = D_e(T_l)$; $\tau_e^0 = \tau_e(T_l)$. Существование таких страт (рис. 1) связано с тем, что из страты, т. е. области высокой температуры, благодаря термодиффузии происходит интенсивный выброс носителей. Вследствие этого концентрация носителей в ней, а следовательно, и проводимость плазмы σ оказываются значительно меньше, чем на периферии страты. Поэтому разогревающая носители мощность j^2/σ оказывается наибольшей в центре

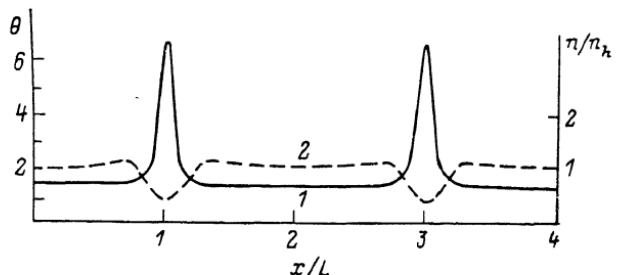


Рис. 1. Распределения температуры $\Theta = T/T_l$ (1) и концентрации носителей n (2) в разогретой ЭДП в виде страт. Результаты численного моделирования уравнений (7), (8) при $l^2/L^2 = 10^{-3}$, $\tau_s^0/\tau_r = 5 \cdot 10^{-4}$, $\alpha = -1/2$, $s = 3/4$, $A = 0.5$, $\nu_i \tau_r = 900 \exp(-31.5/\Theta)$.

страты, что и поддерживает в ней высокое значение температуры [3]. Таким образом, существование страт (рис. 1) принципиально связано с интенсивным выбросом из этих областей горячих носителей. При T , больших температуре Дебая, условия (5) выполняются для многих полупроводников, причем максимальное значение температуры в стратах T_m может быть ограничено процессом межзонной ударной ионизации носителей [4]. При этом устойчивые страты образуются при таких параметрах ЭДП, когда термодиффузия справляется с выбросом носителей, образующихся в страте за счет ударной ионизации [4].

В данной работе рассматривается противоположная ситуация, когда генерируемые в центре страт за счет ударной ионизации носители приводят к развалу образующейся страты. Такой эффект реализуется, когда благодаря экспоненциальной зависимости ν_i от T выполняется условие

$$\nu_i(T_m) \tau_r(T_m, n_m) \gg 1. \quad (6)$$

В свою очередь из теории страт [5] следует, что температура T_m в центре страт тем больше, чем с большим запасом выполнены условия (5). Иными словами, при выполнении (5) и (6) в неустойчивой однородной ЭДП стационарные страты образовываться не могут.

Картина возникающей в этом случае турбулентности должна представлять собой процесс случайного зарождения страт в некоторых областях ЭДП, последующий их развал за счет ударной ионизации, когда температура в центре страт достигает некоторой критической величины, случайное возникновение новых страт в других областях и т. д. Именно такой процесс и наблюдался при численных исследованиях (рис. 2). Страты разваливались за время, много меньшее времени рекомбинации носителей τ_r (ср. два состояния ЭДП на рис. 2 при $t = t_3$ и $t = t_4 = t_3 + 5 \cdot 10^{-3} \tau_r$). Случайное же зарождение новых страт в слабонеоднородной неустойчивой ЭДП происходило за время $\sim \tau_r$ при небольших превышениях тока, точнее — величины $A \sim j^2$ над критическим значением $A = A_c$, при котором однородная ЭДП становится неустойчивой. По мере увеличения A время зарождения новых страт резко уменьшалось, а хаотическое поведение ЭДП становилось более сложным (рис. 3).

Для простоты анализировался случай, когда s и $\alpha = \text{const}$, а разогрев ЭДП осуществлялся высокочастотным полем с частотой ω ($\tau_e^{-1} \ll \omega \ll \tau_p^{-1}$; τ_p — время релаксации импульса). При этих условиях из

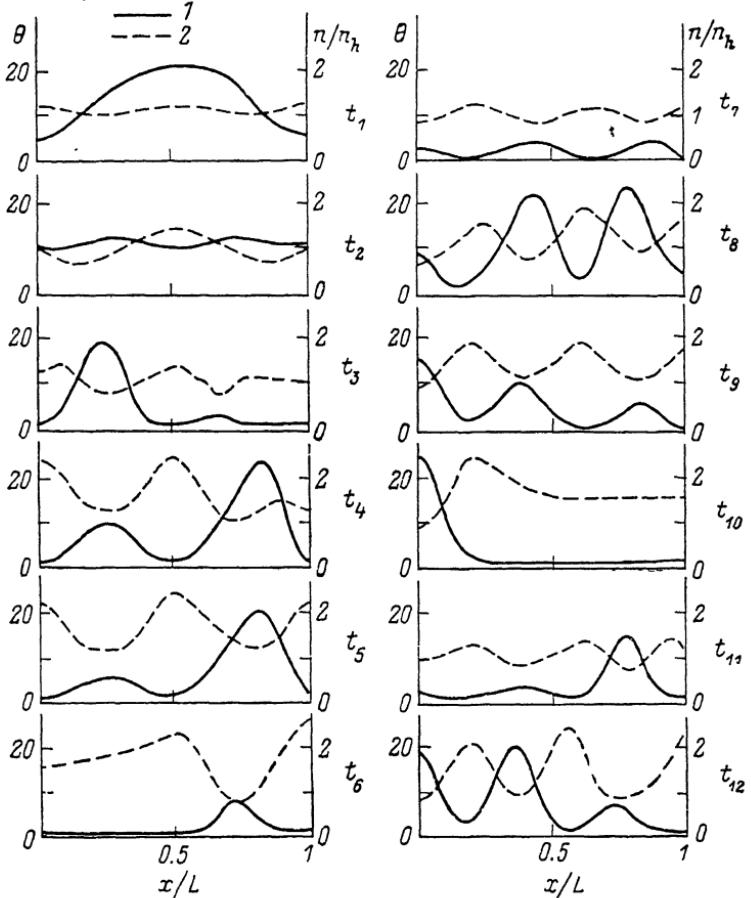


Рис. 2. Картину турбулентности в ЭДП: распределения температуры $\Theta = T/T_L$ (1) и концентрации носителей n (2) в некоторые последовательные моменты времени. Результаты численного исследования уравнений (7), (8) при $A=1.29$, $A_c=0.4$, $s=1$, $\alpha=-1/2$, $l^2/L^2=10^{-4}$, $\tau_e^0/\tau_r=5 \cdot 10^{-5}$, $v_i\tau_r=900 \exp(-31.5\theta)$.

В качестве начальных возмущений при $t=0$ взяты: $\eta=1.7-0.1 \cos 2\pi x$, $\Theta=2.9+0.1 \cos 2\pi x$ ($t_1=0.003\tau_r$, $t_2=0.008\tau_r$, $t_3=2.184\tau_r$, $t_4=2.189\tau_r$, $t_5=2.190\tau_r$, $t_6=2.239\tau_r$, $t_7=4.784\tau_r$, $t_8=4.789\tau_r$, $t_9=4.793\tau_r$, $t_{10}=4.799\tau_r$, $t_{11}=7.156\tau_r$, $t_{12}=7.163\tau_r$).

(1)–(4) следует, что уравнения, описывающие неоднородные состояния в ЭДП, можно записать¹

$$(3/2)\tau_e^0 \partial(\eta\theta^{-\alpha})/\partial t = l^2 \partial^2(\eta\theta)/\partial x^2 + A\theta\eta^{-1} - \eta\theta^{-1-\alpha-s}(\theta-1), \quad (7)$$

$$\tau_e \partial(\eta\theta^{-1-\alpha})/\partial t = L^2 \partial^2\eta/\partial x^2 + 1 - \eta\theta^{-1-\alpha}[1 - v_i(\theta)\tau_r], \quad (8)$$

где

$$\Theta = T/T_L, \quad \eta = nD/n_h D^0, \quad n_h = G_0\tau_r, \quad A = [\tau_e^0/2\mu_e^0(1+b^{-1})T_L n_h^2] j^2$$

— уровень разогрева ЭДП; $\mu_e^0 = \mu_e(T_L)$; j^2 — среднее за период изменения поля значение j^2 . При численных исследованиях уравнений (7), (8) в зависимости от параметров ЭДП были прослежены следующие сценарии возникновения турбулентности.

1. При некотором значении тока $j^2=j_c^2$, т. е. величине $A=A_c$, пространственно-временной хаос (рис. 2) возникает при расслоении однородного состояния ЭДП.

¹ Неоднородные состояния в плоскости, перпендикулярной линиям тока, в рассматриваемом случае не образуются [3]. Уравнения (7), (8) описывают также неоднородные состояния в «симметричной» ЭДП, разогретой постоянным электрическим полем [4].

2. При $A = A_c$ в ЭДП спонтанно образуются страты (рис. 1). При увеличении тока величина температуры в стратах увеличивается и при некотором $A_t > A_c$ в ЭДП спонтанно возникает турбулентность.

3. При $A = A_c$ образуются страты (рис. 1). По мере увеличения A в результате локального пробоя между стратами число страт в ЭДП скачкообразно последовательно удваивается [5] и только при достаточно большом значении A возникает турбулентность.

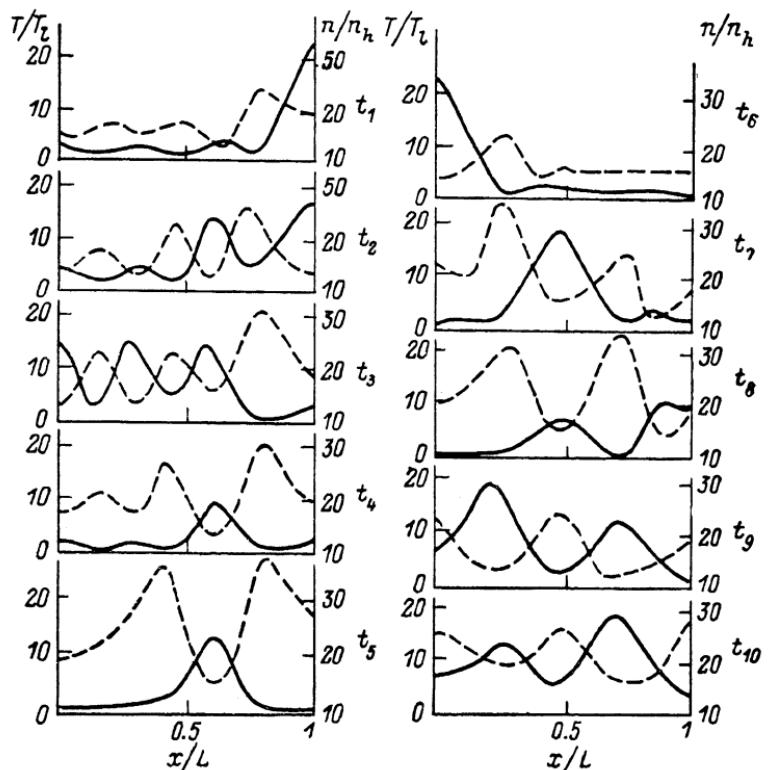


Рис. 3. Картина турбулентности в ЭДП: то же, что и на рис. 2, но при $A=100$.

В качестве начальных возмущений при $t=0$ взяты: $\eta=7-\cos 2\pi x$, $\theta=29+3 \cos 2\pi x$ ($t_1=5.056 \tau_r$, $t_2=5.059 \tau_r$, $t_3=5.062 \tau_r$, $t_4=5.068 \tau_r$, $t_5=5.083 \tau_r$, $t_6=5.875 \tau_r$, $t_7=5.881 \tau_r$, $t_8=5.887 \tau_r$, $t_9=6.656 \tau_r$, $t_{10}=6.659 \tau_r$).

При разогреве в постоянном поле асимметричной ЭДП в уравнениях (7), (8) возникают сносовые члены, пропорциональные j [3], благодаря чему турбулентность значительно усложняется.

Разогретая ЭДП является одним из примеров активных систем с диффузией [5], свойства которых описываются уравнениями типа

$$\tau_\Theta \partial \Theta / \partial t = l^2 \Delta \Theta - q(\Theta, \eta, A), \quad \tau_\eta \partial \eta / \partial t = L^2 \Delta \eta - \dot{Q}(\Theta, \eta, A). \quad (9)$$

В таких системах по одному из параметров — активатору (Θ) — в некотором диапазоне уровней возбуждения A осуществляется положительная обратная связь, т. е. $q'_\Theta \equiv \partial q / \partial \Theta < 0$, а по другому — ингибитору η — отрицательная обратная связь, т. е. $Q'_\eta \equiv \partial Q / \partial \eta > 0$. Условие неустойчивости страт (6) сводится, как следует из (8), к тому, что в центре страт величина $Q'_\eta < 0$, т. е. неустойчивость страт связана с тем, что в их центре отрицательная обратная связь по ингибитору сменяется на положительную.

Список литературы

- [1] Ландау Л. Д., Лишниц Е. М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 736 с.
- [2] Кернер Б. С., Осипов В. В. // ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 6. С. 2201—2214; ДАН СССР. 1983. Т. 270. № 5. С. 1104—1108.
- [3] Кернер Б. С., Осипов В. В. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 8. С. 2342—2346.
- [4] Дубицкий А. Л., Кернер Б. С., Осипов В. В. // ФТП. 1986. Т. 20. № 7. С. 1195.
- [5] Кернер Б. С., Осипов В. В. // УФН. 1989. Т. 157. № 2. С. 201—266.